

## キュウリホモプシス根腐病の伝染源対策

### 【1 技術のポイント】

- (1) きゅうり栽培打ち切り後、ただちにキルパーを灌水処理し、すみやかに植物体を枯死させることで、副次的にホモプシス根腐病菌の根部での増殖を抑制できます（図1、図2）。これにより、根部での偽子座・疑似微小菌核（耐久生存組織）の形成が抑制され、次作の伝染源密度を低減できます。
- (2) きゅうり枯死後 10 日以上経過すると、根部に耐久生存組織となる偽子座・疑似微小菌核の形成が多くなります（図1）。このため、本剤の処理は、栽培打ち切り後すみやかに実施してください。



図1 発病株の根部に形成される偽子座・疑似微小菌核（耐久生存組織）

**摘要** 罹病株の根部に形成される偽子座・疑似微小菌核が耐久生存組織となって次作の伝染源となる。偽子座および疑似微小菌核は、きゅうり自然枯死 10 日以降に形成が多くなる。



図2 栽培打ち切り直後のキルパー処理による偽子座形成抑制効果（処理 29 日後）

**摘要** 無処理区では偽子座・疑似微小菌核の形成が多いため、根部全体が褐変し、先端部は脱落している。一方、キルパー処理区では、根部組織内に薬液が浸透して植物体が枯死し、根部での病原菌の増殖も抑制されている。

### 【2 留意事項】

- (1) キルパーによる古株枯死処理を実施する際には、農薬ラベルや技術資料を必ず確認してください。
- (2) 多発圃場や排水不良の圃場では、栽培期間中に萎れが発生しなかった場合でも、栽培打ち切り時点で根部に偽子座・疑似微小菌核が多量に形成されている場合があります。偽子座・疑似微小菌核の形成が進んでいない段階でキルパーを処理しなければ効果が低くなるので注意してください。
- (3) キルパーによる古株枯死を実施しない場合は、栽培打ち切り後、できるだけ早めに抜根して、マルチ上に置いて乾燥させるなどして偽子座・疑似微小菌核の形成を抑制してください。台木部付近で主茎を切断し、根部を引き抜かず土中に放置すると偽子座・疑似微小菌核が根部残渣に多量に形成され、次作の伝染源となります。
- (4) 本剤による古株枯死は、栽培終了後に病原菌が根部で増殖することを抑制するための処置です。圃場におけるホモプシス根腐病の発生状況に応じて、転炉スラグを用いた土壌 pH 改良技術やクロロピクリンくん蒸剤による土壌消毒技術を別途実施してください。